2013S2-004 (2013年10月~2016年9月)



⇒ 偏極中性子反射率

と相補的

Sample表面

面直磁化のFeMn/Ni/Cu(100)に面内方向に磁場

を印加することで界面付近の面内磁化成分を観察

0.2 nm (< < < 1.8 nm (< < <

q(nm⁻¹

H.

外的要因による磁性薄膜の特性制御を目指した 軟X線XMCDを中心とする相補的研究

Complementary studies on magnetic thin films aiming at control of their properties by external factors mainly by means of soft X-ray XMCD

実験責任者: 雨宮 健太¹

実験参加者: 藤森 淳², 小出 常晴¹, 酒巻 真粧子¹, 石上 啓介², 芝田 悟朗², 堀尾 眞史2, 坂本 祥哉2, 野中 洋亮2, 岡崎 浩三2, 山本 孟3, 川邊 諒3 ¹物構研PF, ²東大院理, ³東工大院総合理工

本研究の全体としての目的は、構造歪み、界面効果、電界効果といった外的要因によって様々な興味深い特性を示す磁性薄膜に 対して、軟X線XMCDを中心とした、EXAFS、偏極中性子反射率なども含めた相補的な実験を行うことで、スピン磁気モーメント、軌 道磁気モーメント,電子状態,結晶構造を,それらの異方性や深さ方向の分布も含めて明らかにし,外的要因によって磁性薄膜が示 す特異な性質がどのようにして発現しているのかを解明するとともに、その情報を新たな試料の作製にフィードバックして、磁性薄膜 の特性を制御することである。

このS2課題は、その中で放射光を用いた測定の部分に相当する。したがって、単に測定を行って磁性や構造を調べて特性の発現 機構を解明するだけでなく、その情報をもとに新たな物質をデザイン・作製し、予想したような特性が得られるかどうかを検証するとと もに、その試料に対して再び各種の測定を行うことで、特性の発現についてのより深い理解を得たうえで、さらに新たな試料の作製 へとつなげていくことを常に意識して研究を行っている。

本研究のターゲットと実験手法







外的要因によって磁性薄膜が示す特性の発現機構の解明

⇒ 磁性薄膜の特性を制御

In situ実験,および物質開発を行う研究者との密接な連携に より、測定結果を高速にフィードバック



深さ分解XMCDと偏極中性子反射率を相補的に 用いることによって、反強磁性FeMnと強磁性Niの 界面におけるねじれたスピン状態の存在を強く示 唆する結果を得ることができた

偏極中性子反射率の相補的利用

深さ分解XMCD法のメリット・デメリット

原子層レベルの分離が可能

(3) 深い部分(埋もれた界面)を観察できない

FeMn

Ni

(25 ML)

(11 ML)

Cu(100)

電子の有効脱出深度は0.5-2 nm

電子の有効脱出深度は0.5-2 nm

電子の出射角度依存性を利用しているため

↓↑

偏極中性子

(2) 表面付近の磁性を敏感に観察できる

(4) 残留磁化中でないと測定できない

(1) 深さ分解能が高い

Н

K. Amemiya et al., PRB 89 (2014) 054404. K. Amemiya et al., JPS Conf. Proc., in press.

研究経過(1): 電界印加による薄膜の磁性の制御[1,2,4] 研究経過(2): 強磁性半導体の磁化過程[6] Fe/BaTiO₃薄膜における電界効果の研究





XMCDによる新しいn型強磁性半導体(In,Fe)Asの磁化過程の研究。(左)Fe L2,3吸収端における XASとXMCD。(右上)XMCD強度の磁場・温度依存性。Tc = 40 Kより高温はBrillouin関数でスケー ルされ, 超常磁性ドメインが形成されていることを示している。(右下)上記のデータから示唆される, 超常磁性ドメイン数の温度低下に伴う増加。

界面にFeの酸化物が存在し、電圧印加による保磁力変化とFe-O距離の変化に相関。 意図的に界面酸化物層を挿入した実験(ポスターNo. 097F)やNiO/Ni/Cu(100)における電界効果の研究も実施。

まとめ

[arb.unit]

Intensity

700

710

- 軟X線可変偏光ビームラインBL-16A, 硬X線XAFSライン等を用いて研究を実施。
- 対象として, Fe/BaTiO₃薄膜(界面に酸化物層を挿入したもの含む), NiO/Ni/Cu(001)薄膜へ の電界印加, 強磁性半導体の磁化過程, イオン照射効果の解明, 磁気トンネル接合界面[3], 格子歪みの効果[5]など。
- 今後、深さ分解XMCDや偏極中性子反射率も活かして界面の状態を詳細に観察。

[1] M.Sakamaki and K.Amemiya, "Observation of Fe/BaTiO₃ interface state by x-ray absorption spectroscopy", e-J. Surf. Sci. Nanotech., submitted.

[2] K.Amemiya and M.Sakamaki, "Voltage-induced Changes in Magnetism of FeCo/BaTiO₃ Thin Films Studied by X-ray Absorption Spectroscopy", e-J. Surf. Sci. Nanotech., submitted.

[3] V.R.Singh et al, "Electronic and magnetic properties of off-stoichiometric Co₂MnSi/MgO interfaces studied by x-ray magnetic circular dichroism", Phys. Rev. B, submitted.

[4] M.Sakamaki and K.Amemiya, "Role of interface oxide state for the electric field effect of Fe/BaTiO₃ investigated by x-ray absorption spectroscopy", in preparation (to be submitted to Phys. Rev. B).

[5] K.Ishigami et al., "Thickness-dependent magnetic properties and strain-induced orbital magnetic moment in SrRuO₃ thin films", in preparation (to be submitted to Phys. Rev. B).

[6] S.Sakamoto et al., "Magnetization Process of the n-type Ferromagnetic Semiconductor (In,Fe)As:Be Studied by X-ray Magnetic Circular Dichroism", in preparation (to be submitted to Appl. Phys. Lett.).